Облікова картка ДіР

Image not found or type unknow

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0209U002698

Державний реєстраційний номер: 0106U001682

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 12-03-2009

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Дослідження фізичних механізмів струмопереносу в напівпровідникових інжекційниxx структурах при дії зовнішніх збурюючих факторів (світло, магнітне поле, тиск)

Початок етапу: 01.2006

Закінчення етапу: 12.2008

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова

Код за ЄДРПОУ: 02071091

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (048) 731-71-51

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський Політехнічний Інститут"

Код за ЄДРПОУ: 00027677

Місцезнаходження: пр. Перемоги 37, м. Київ, Київ, 03056, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 0442048428

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Дослідження фізичних механізмів струмопереносу в напівпровідникових інжекційнихх структурах при дії зовнішніх збурюючих факторів (світло, магнітне поле, тиск)

Назва роботи англійською:

Investigation of the physical mtchanisms of current in the semiconductors injection structures at the action of external revolting factors (ligght, magnetic field, pressure)

Реферат українською:

1. Об'єкт досліджень - інжекційні структури на базі однорідних матеріалів та однорідних матеріалів та напівпровідників з макро- та мікронеоднорідностями (Ge, Si з глибокими домішкови ми центрами, гетеропереходи, варизонні напівпровід ники). Мета роботи - створення концепції фізичних механізмів струмопереносу в напівпровід-икових інжекційних структурах при дії зовнішніх збурюючи факторів (світло, магнітне поле, тиск). Обгрунтовано модуляцію параметрів розподілу нерівноважних носіїв заряду через інжекцію в напівпровідниках з глибокими домішковими центрами. Розроблено лабораторні моделі високочутливих сенсорів світла, магнітного поля , тиску.

Реферат англійською:

3. Objects of the researches are injection structures on the base of homogeneous materials and semiconductors with macro- and micrograd ients (Ge, Si with deep impurities levels, heterojunctions, graded-band gap semiconductors). The purpose of the work- creation of conception of physical mechanisms of current in semiconductor injection structures at the action of external revolting factors (light, magnetic field, pressure). Modulation of parameters of distributing of non-equilibrium transmitters of charge is grounded at an injection in semiconductors with deep impurities levels The laboratory models of highly sensitive sensors of light, sensors of IR-light, magnetic field pressure are developed.

Індекс УДК: 537.311.322, УДК 621.382.4+5

Коди тематичних рубрик: 29.19.31

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Курмашев Шаміль Джамашевич

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

1. Vikulin I.V., Kurmashtv Sh. D., Stafeev V.I. Injection-base photodetectors// Semiconductors.- №1, 2008.- P. 112-126.. 2. Vikulin I.V., Kurmashev Sh. D. Photodetector on the base of uni-junction transistor and photodiode // Photoelectronics -2008, N17.- P. 88-90. .3. Курмашев Ш.Д., Мирончeнко Т.И. Оптичий модуля-тор //Патент України №UA 285026 -Бюл.№20, 2007. 4. Глауберман М.А., Каніщева Н.А. Фізичні та модельні уявлення про

гальваномагнітні ефекти в біпо-лярних напівпровідникових структурах//Сенсорна елек-троніка і мікросистемні технології.- 2006.- №1.- С. 17-23.

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Сминтина Валентин Андрійович
д. ф.-м. н., 01.04.10

Перелік осіб-виконавців

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

